

## 地球環境にやさしい技術で 世の中に貢献



重兼 壽夫 (しげかね ひさお)

富士電機デバイステクノロジー株式会社  
取締役社長

新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、志も新たに新年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

富士電機デバイステクノロジー株式会社はパワー半導体、ディスク媒体、画像デバイスの各事業を通じ『お客様を通して世の中に貢献する』という理念のもと社会への貢献と企業価値の増大に向け取り組んでいます。

『お客様を通して世の中に貢献する』には以下の事柄が大切だと考えます。

- (1) 美しい地球環境を守るため省エネルギー、温暖化ガス対策など人類共通の目標に貢献できること
- (2) お客様とともに上記を実現するため、新製品の目標値をお客様と一緒につくること
- (3) 上記目標値を製品化する確固たる技術とものづくりを確立すること

当社を取り巻く事業環境は日々厳しさを増しています。悪化する市場環境の中でピンチをチャンスに変える施策を推進しながら、地球環境にやさしく、次の世代に明るい未来を残せる技術開発とものづくりを進めます。

産業エレクトロニクス分野では電力変換効率を高める技術の確立と、市場のニーズに合ったパワー半導体製品の普及が課題です。電力変換技術の向上には富士電機グループの力を結集し、取り組んでいます。当社のパワー半導体製品は、省エネルギーをはじめ省資源、安心、経済性に加えて電磁環境をよくする施策を推進し、より一層の普及に努めます。

省エネルギー、インフラ分野では第6世代 IGBT モジュール「V シリーズ」を製品化しました。最先端技術を用いた低損失 IGBT チップ技術と、高放熱パッケージ技術を融合することにより、IGBT モジュールの大幅なパワー密度の向上が達成できました。例えば 1,200 V 耐圧のクラスにおいて約 10% 以上の省エネルギーを実現するとともに約 30% の小型化を実現しました。電力変換機器の省エネルギー化と省資源化に貢献します。

自動車分野では、地球にやさしいハイブリッド自動車の普及が急がれています。当社は心臓部に当たるパワーコントロールユニットの省エネルギーと省資源を実現する新製品の量産準備を進めています。パワーコントロールユニットの高性能化を通じてハイブリッド自動車の普及に貢献します。

情報機器分野では省エネルギーと低ノイズを両立し、使いやすさを改善した第6世代 MOSFET 「Super FAP-E<sup>3</sup> 900 V シリーズ」を製品化しました。省エネルギーと低ノイズの両立に加え、壊れにくさを向上したのが特徴です。これらの改善によりスイッチング電源の高効率・高信頼性および設計自由度の向上に貢献します。

情報産業分野では、業界で始めて高記録密度化技術の一つである ECC (Exchange-coupled Composite) 媒体の製品化に成功し、2.5 インチ 250 G バイト/枚、3.5 インチ 500 G バイト/枚の生産を開始しました。従来の垂直磁気記録媒体に独自の改良を加えることで、書き込みやすさと高い熱安定性を実現しました。この技術はさらに磁性結晶粒子の微細化を進めることで、次世代の高記録密度化にも対応するとともに、省資源にも貢献します。

画像情報機器分野においてはトナー消費量の低減を図りながら高解像度、高速性、高耐久性を誇る感光体を開発しました。独自の材料技術と評価技術を駆使し、高性能な感光体製品を提供することで、情報社会の発展に貢献します。

目まぐるしく変わる事業環境にいち早く対応することが当社の課題です。当社は 2008 年 12 月から事業運営に必要な情報をより早く経営中枢に集中できる体制を取りました。ものづくりでは松本、山梨の両事業所をマザー工場と位置づけ、研究・開発から生産まで一貫した当社ノウハウの集積を行います。

富士電機デバイステクノロジー株式会社は市場ニーズに沿った製品を顧客起点で創造し、地球環境にやさしいものづくりを通じて感謝の気持ちを社会に伝え、技術で恩返しする企業を目指します。



\*本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する  
商標または登録商標である場合があります。